

(2002/11/29)

増設メモリ

## 増設メモリ

### 1. 機能仕様

型名	N8102-130	N8102-131	N8102-132	N8102-137
容量	128MB	256MB	512MB	1GB
仕様	SDRAM-DIMM,Registered			
動作クロック	100/133MHz			
駆動電圧	3.3V			
バッファ	有			
増設単位	1 枚セット			
接続対象装置	110Ee, 110EeS, 120Ee, 110Rc-1			

型名	N8102-150	N8102-151	N8102-152
容量	128MB	256MB	512MB
仕様	SDRAM-DIMM		
動作クロック	100/133MHz		
駆動電圧	3.3V		
バッファ	無		
増設単位	1 枚セット		
接続対象装置	110Ef		

型名	N8102-174	N8102-175	N8102-176
容量	128MB	256MB	512MB
仕様	DDR266(PC2100) SDRAM-DIMM		
動作クロック	200/266MHz		
駆動電圧	2.5V		
バッファ	無		
増設単位	1 枚セット		
接続対象装置	110Ga		

N8102-176 搭載時は#1 スロット目から搭載すること。

N8102-176 は最大 2 枚まで搭載可。

型名	N8102-171	N8102-172	N8102-173
容量	256MB	512MB	1GB
仕様	DDR266(PC2100) SDRAM-DIMM Registered		
動作クロック	200/266MHz		
駆動電圧	2.5V		
バッファ	有		
増設単位	1 枚セット		
接続対象装置	120Ga		

型名	N8102-138	N8102-139	N8102-140	N8102-141
容量	256MB	512MB	1GB	2GB
仕様	SDRAM-DIMM,Registered			
動作クロック	100/133MHz			
駆動電圧	3.3V			
バッファ	有			
増設単位	2枚セット			
接続対象装置	120Lf			

	N8102-118	N8102-119	N8102-120	N8102-121
容量	256MB	512MB	1GB	2GB
仕様	DDR200(PC1600) SDRAM-DIMM			
動作クロック	200MHz			
駆動電圧	2.5V			
バッファ	有			
増設単位	2枚セット			
接続対象装置	120Me			

型名	N8102-166	N8102-167	N8102-168
容量	128MB	256MB	512MB
仕様	SDRAM-DIMM,LowProfile		
動作クロック	100/133MHz		
駆動電圧	3.3V		
バッファ	無		
増設単位	1枚セット		
接続対象装置	110Rd-1		

型名	N8102-133	N8102-134	N8102-135	N8102-136
容量	256MB	512MB	1GB	2GB
仕様	SDRAM-DIMM,Registered			
動作クロック	100/133MHz			
駆動電圧	3.3V			
バッファ	有			
増設単位	2枚セット			
接続対象装置	120Rb-1, 120Rd-2			

型名	N8102-154	N8102-155	N8102-156	N8102-157
容量	256MB	512MB	1GB	2GB
仕様	DDR200(PC1600) SDRAM-DIMM, Registered,LowProfile			
動作クロック	200MHz			
駆動電圧	2.5V			
バッファ	有			
増設単位	2枚セット			
接続対象装置	120Rc-1, 120Re-2			

型名	N8102-124	N8102-125	N8102-126	N8102-127
容量	512MB	1GB	2GB	4GB
仕様	DDR200(PC1600) SDRAM-DIMM,Registered			
動作クロック	200MHz			
駆動電圧	2.5V			
バッファ	有			
増設単位	4枚セット			
接続対象装置	140Hc,140Rb-4			

型名	N8102-143	N8102-144	N8102-145
容量	1GB	2GB	4GB
仕様	SDRAM-DIMM,Registered		
動作クロック	133MHz		
駆動電圧	3.3V		
バッファ	有		
増設単位	4枚セット		
接続対象装置	180Rc-4		

SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)

従来のDRAMと比べて内部は基本的に同じであるが、外部バスインターフェイスが一定周期のクロック信号に同期して動作するように改良されたDRAM。

Pentium,Pentium II, Pentium , Pentium Xeon,Pentium 4,XeonなどのCPUも、その外部バスはクロックに同期して動くため、CPUとSDRAMのクロックを共通にすればアクセス時のロスを少なくできる。

SDRAMで高速化できるのは、1クロック毎にデータを転送するバーストモードである。従来のDRAMを利用する場合、Pentium,Pentium II ,Pentium , Pentium Xeon,Pentium 4,Xeonではバーストモード時にウェイトを挿入しなければならない事が多いが、シンクロナスDRAMを用いればノーウェイトでCPUのバーストモードに追従できる。ただし、バーストモードの最初のアクセスは速くならない。

DDR SDRAM(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)

SDRAMを改良して、外部クロックの2倍の周期でデータをやり取りできるようにしたSDRAM。SDRAMがクロックの立ち上がりのみを利用するのに対し、立ち上がりと立ち下りの両方を利用し、同じクロックで2倍のデータ転送を実現する。

## 2.注意事項

- ・ Express5800 シリーズ用に販売されている他社製メモリは動作保証の範囲外となるため、Express5800 純正品のメモリを使用すること。